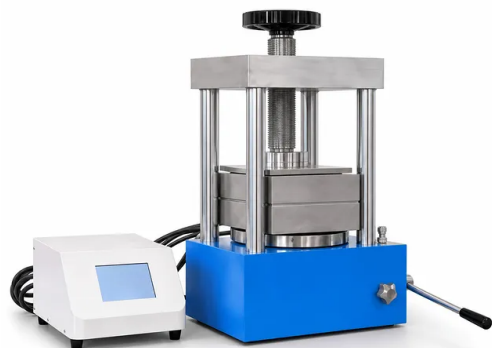


研究室試料調製用 24トン 200×200Mm 一体型加熱プレス

商品番号: XP55



前書き

24トンのクランプ力と200×200mmの加熱プラテンを備えたプロフェッショナル一体型加熱プレスで、電池研究、材料試験、試料調製に最適です。300℃までの精密温度制御により、信頼性の高い安定した結果を実現します。

詳細を学ぶ

用途	説明	主なメリット
電池電極・電解質のプレス成形	リチウムイオン電池や次世代電池用の正極/負極粉末の固結化、固体電解質ペレットの成形。	均一な密度分布によりホットスポットを防止し、ペレット全体で安定したイオン伝導性を確保します。
高分子フィルムのエンボス加工・ラミネーション	多層高分子フィルムの熱接合、マイクロ流体チップの封止、ラポオンチップデバイスの表面テクスチャ加工。	精密な温度・圧力制御により、熱劣化させることなく微細なナノ構造を維持します。
FTIR・XRF用ペレット調製	赤外分光分析用の透明KBrペレット、蛍光X線分析用の融解ビーズの作製。	空気の混入や厚さのばらつきを排除し、再現性の高いスペクトルベースラインを得られます。
複合材料の開発	金属基複合材料のホットプレス、セラミック強化ポリマー、炭素繊維プリプレグの固結化。	制御された温度・圧力プロファイルの下で、繊維の含浸最大化とボイド除去を実現します。
医薬品錠剤のパイロット生産	処方試験や安定性試験のための粉末配合物の小ロット錠剤圧縮。	プレスパラメータの完全なデータロギングにより、FDA/EMAの文書化やスケールアップ研究を支援します。
粉末冶金の焼結	最終焼結前の金属・セラミック粉末の昇温下での予備圧縮。	グリーン密度を向上させ、焼結収縮を低減して、ネットシェイプ精度を向上させます。
半導体ウェーハの接合	制御された力と温度を用いたシリコンウェーハまたはチップオンフレックスアセンブリの熱圧縮接合。	ボイドのない均一な接合ラインを実現し、微小電気機械システム（MEMS）製造に不可欠な品質を得られます。

パラメータ	XP55
モデル	XP55
プレス容量	0 - 24 トン
プラテン作業温度	室温 - 300 °C
加熱出力（合計）	1200 W (2 × 600 W)
プラテン寸法	200 × 200 mm
プラテン冷却	一体型水循環
温度制御	デュアルゾーンPID、±2 °C安定性
表示・制御	4.3インチタッチスクリーン、プログラム対応
電源	220 V, 50 Hz, 単相

パラメータ	XP55
全体寸法（幅 × 奥行 × 高さ）	950 × 260 × 525 mm
正味重量	180 kg